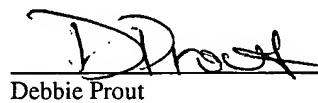




PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the U.S. Postal Service as first class mail in an envelope addressed to Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on May 24, 2004.



A handwritten signature of Debbie Prout, which appears to be "D. Prout".

Debbie Prout

Applicant : Hiromichi Watanabe, et al.
Application No. : 10/723,349
Filed : November 25, 2003
Title : SUBSTRATE FOR CIRCUIT WIRING

Grp./Div. : N/A
Examiner : N/A

Docket No. : 51580/DBP/A400

**LETTER FORWARDING CERTIFIED
PRIORITY DOCUMENT**

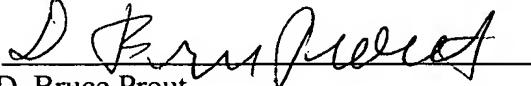
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Post Office Box 7068
Pasadena, CA 91109-7068
May 24, 2004

Commissioner:

Enclosed is a certified copy of Japan patent Application No. 2002-342556, which was filed on November 26, 2002, the priority of which is claimed in the above-identified application.

Respectfully submitted,
CHRISTIE, PARKER & HALE, LLP

By 
D. Bruce Prout
Reg. No. 20,958
626/795-9900

DBP/djp

Enclosure: Certified copy of patent application
DJP PAS566698.1-* 05/24/04 9:06 AM

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2002年11月26日

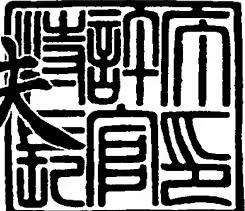
出願番号 Application Number: 特願2002-342556

[ST. 10/C]: [JP2002-342556]

出願人 Applicant(s): 富士通テン株式会社

2003年11月17日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫


【書類名】 特許願
【整理番号】 1024757
【提出日】 平成14年11月26日
【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿
【国際特許分類】 H05K 1/05
【発明の名称】 回路配線基板
【請求項の数】 9
【発明者】
【住所又は居所】 兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号 富士通テ
ン株式会社内
【氏名】 渡邊 弘道
【発明者】
【住所又は居所】 兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号 富士通テ
ン株式会社内
【氏名】 深津 佳史
【発明者】
【住所又は居所】 兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号 富士通テ
ン株式会社内
【氏名】 貝野 秀昭
【特許出願人】
【識別番号】 000237592
【氏名又は名称】 富士通テン株式会社
【代理人】
【識別番号】 100077517
【弁理士】
【氏名又は名称】 石田 敬
【電話番号】 03-5470-1900

【選任した代理人】**【識別番号】** 100092624**【弁理士】****【氏名又は名称】** 鶴田 準一**【選任した代理人】****【識別番号】** 100113826**【弁理士】****【氏名又は名称】** 倉地 保幸**【選任した代理人】****【識別番号】** 100082898**【弁理士】****【氏名又は名称】** 西山 雅也**【選任した代理人】****【識別番号】** 100081330**【弁理士】****【氏名又は名称】** 樋口 外治**【手数料の表示】****【予納台帳番号】** 036135**【納付金額】** 21,000円**【提出物件の目録】****【物件名】** 明細書 1**【物件名】** 図面 1**【物件名】** 要約書 1**【包括委任状番号】** 9814498**【プルーフの要否】** 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 回路配線基板

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 電子部品が、金属基板に積層された絶縁層上の配線パターンに実装された回路配線基板であって、

前記電子部品の実装部分が、前記絶縁層の線膨張率より小さい線膨張率を有する樹脂材料によって樹脂封止されていることを特徴とする回路配線基板。

【請求項 2】 前記絶縁層は、高放熱化する無機充填材と低弹性化する弾性充填材を含有する樹脂材料で形成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の回路配線基板。

【請求項 3】 前記樹脂封止する樹脂材料は、無機充填材が充填されることによって、封止樹脂の線膨張率が調整されることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の回路配線基板。

【請求項 4】 前記無機充填材は、電気絶縁性及び高熱伝導性を有することを特徴とする請求項 3 に記載の回路配線基板。

【請求項 5】 前記無機充填材は、酸化珪素、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、窒化珪素、窒化硼素から、いずれか一つ又は複数が選択されたものであることを特徴とする請求項 4 に記載の回路配線基板。

【請求項 6】 前記金属基板は、アルミニウムベースであることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれか一項に記載の回路配線基板。

【請求項 7】 前記電子部品は、前記配線パターンに半田付けされていることを特徴とする請求項 1 乃至 6 のいずれか一項に記載の回路配線基板。

【請求項 8】 前記電子部品の実装部分が、前記樹脂材料によって前記絶縁層及び前記金属基板と一体的に樹脂封止されていることを特徴とする請求項 1 乃至 7 のいずれか一項に記載の回路配線基板。

【請求項 9】 高温環境下に設置されることを特徴とする請求項 1 乃至 8 のいずれか一項に記載の回路配線基板。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、電子部品などが実装された回路配線基板に関し、特に、高温環境下（105℃～140℃）で使用される電子機器内に装着されるのに最適であり、金属基板本体の線膨張が電子部品などの実装に影響することを抑制した回路配線基板に関する。

【0002】**【従来の技術】**

電子部品を実装した電子機器、例えば、自動車などのエンジンなどを制御するための電子制御装置のように、高温環境下であり、かつ狭隘なスペース内に取り付けられる車載用電子機器においては、その小型化、省スペース化と共に、電子機器をエンジルーム内に設置するための高放熱化が要望されている。

【0003】

エンジルーム内は温度が高く、温度変化が大きいなど過酷な環境であり、高耐熱化が図られ、電子部品が実装される回路配線基板のベース基板には、セラミック材によるものが使用され、放熱には、放熱用フィンなどの放熱装置を必要としていた。そのため、電子機器は、嵩張るものとなり、小型化、省スペース化に限界があった。そこで、小型化、省スペース化、低コスト化、しかも、高放熱化を図ることができる基板が必要とされ、このような用途に対して、放熱性に優れる金属ベースの回路配線基板が使用され始めている。

【0004】

従来、自動車のエンジルーム等の高温環境下に搭載される電子制御装置等に用いられる電子回路の基板として、高耐熱性のセラミック基板を使用することが一般的であった。これに対して、アルミニウム合金等による金属基板が用いられるようになってきたのは、コストがセラミック基板に比べて低い、セラミック基板が割れやすくて取り扱いが不便である、セラミック基板が放熱装置を必要とする、金属基板は従来の樹脂基板と同様のプロセスで製造が可能であり、設計変更が容易であるためであり、特に、高密度実装の必要のない出力ドライブ回路に用いられている。

【0005】

その金属ベース回路配線基板には、熱放熱性や経済的な理由からアルミニウム板が用いられることが多いが、この回路配線基板が電子機器内に組み込まれた実使用下において、回路配線基板に加熱又は冷却が繰り返されると、基板であるアルミニウム板と実装された電子部品、特に、チップ部品との熱膨張率の差に起因して、大きな熱応力が発生し、部品を固定している半田部分、或いは、その近傍にクラックが発生するなど電気的信頼性が低下するという問題がある。

【0006】

また、金属ベース回路配線基板の場合には、金属板を用いていることから、電子部品の実装には、基板表面に絶縁層を必要とする。その絶縁層に低弾性率の材料を用いることによって、金属板と電子部品との間で発生する応力を緩和することができる。しかし、チップ部品のサイズが大きくなればなるほど、前記材料の弾性率を大幅に下げる必要があるが、低弾性率の材料は、一般にアルミニウムや回路導体の銅とは密着性が弱い。

【0007】

そのために、配線パターンなどの導電箔と回路配線基板との密着性に優れた金属ベース回路配線基板が得られないという問題がある。特に、導電箔の回路配線基板との密着性は高温度下で著しく低下するために、105℃を超える環境で使用できるような、耐熱性に優れた金属ベース回路配線基板が得難くなっている。

【0008】

そこで、金属基板と導電箔パターンとの密着性を改善して、応力緩和を向上させることにより、金属ベース回路配線基板が急激な加熱又は冷却を受けても、電子部品の半田部分、或いは、その近傍におけるクラック発生等の異常を生じない、熱放熱性に優れた金属ベース回路配線基板が提案されている（例えば、特許文献1を参照）。

【0009】

この提案されている金属ベース回路配線基板の従来技術による電子部品搭載の回路配線基板の断面図を、図3に示した。

【0010】

図中、符号1は、アルミニウム合金材料等による金属ベースの回路配線基板を

示し、その厚さは、2mmである。符号2は、エポキシ樹脂材料からなる絶縁層であり、該絶縁層2は、回路配線基板1の全表面に、厚さ90μmの膜として形成されている。そして、絶縁層2上には、銅等による導電箔の配線パターン3_1乃至3_3が配設されており、その配線パターン3_1乃至3_3上には、チップなどの電子部品4が、該配線パターン3_1乃至3_3のいずれか2つを跨ぐように載置されている。図3の例では、電子部品4の一端は、配線パターン3_1に半田5_1によって半田付けされ、その他端は、配線パターン3_2に半田5_2によって半田付けされ、電子部品4と配線パターン3_1乃至3_3上で電子回路が形成されている。

【0011】

ところで、従来から、金属基板上に、無機フィラーを充填したエポキシ樹脂等からなる絶縁層を設け、その上に導電箔による配線パターンを配設した金属ベース回路配線基板は知られており、エポキシ樹脂等に無機フィラーの充填により熱放熱性を向上し、高発熱性電子部品を実装する回路配線基板として用いられていた。

【0012】

しかし、図3に示された従来の金属ベース回路配線基板において、熱放熱性を向上させるため、絶縁層2を、無機フィラーを充填したエポキシ樹脂で形成すると、エポキシ樹脂本来の熱膨張係数が無機フィラー充填により小さくなつて硬くなり、その結果、金属基板1の熱膨張係数が大きいので、絶縁層2の熱膨張係数が相対的に金属基板1のそれよりも小さくなる。そのため、その金属ベース回路配線基板が、高温環境化に置かれたとき、金属基板1と絶縁層2の熱膨張係数の差によって、高温環境になると、金属基板1と絶縁層2との剥離が発生する。

【0013】

特許文献1で提案されている金属ベース回路配線基板では、高温環境下における剥離問題を解決する手段として、金属基板1上に形成される絶縁層2を低弾性化することによって、金属基板1から電子部品に伝わる熱応力を緩和させている。その絶縁層2の構成について、図4にその拡大断面図で示した。

【0014】

絶縁層2は、エポキシ樹脂Rをベースとしているが、図示のように、ゴム系フィラーF₁とシリカ系フィラーF₂とが充填されている。ゴム系フィラーF₁によって、弾性が絶縁層2に付与され、シリカ系フィラーF₂によって、高放熱性が付与される。ゴム系フィラーF₁には、通常のエポキシ樹脂にブタジエン系ゴム、アクリルゴム、シリコンゴム等のゴムを分散させることが考えられるが、弾性の付与の仕方として、ウレタン変性を施す、ダイマー酸グリジルエステル、ポリグリコール型エポキシ樹脂、ブチルエーテル変性ビスフェノールA型エポキシ樹脂等の可撓性エポキシ樹脂を使用する、通常のエポキシ樹脂に変性ポリアミン系等の可撓性硬化剤を使用する、或いはそれらを組み合わせ使用すること等を採用することができる。

【0015】

また、高放熱性向上のためには、シリカ系フィラーの他に、電気絶縁性が良好で、しかも高熱伝導率のものとして、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、窒化珪素、窒化ホウ素等があり、単独系でも混合系でも用いることができる。

【0016】

以上のように、エポキシ樹脂R中に、ゴム系フィラーF₁とシリカ系フィラーF₂を充填した絶縁層2とし、熱放熱性を向上しながら、低弾性化を実現している。

【0017】

これにより、金属基板1と、その上に実装された電子部品4との線膨張の違いによって生じる応力が緩和されることになり、電子部品4の半田5₁又は5₂にクラックが発生することを抑制していた。なお、従来の絶縁層は、放熱性を上げるために、シリカ系フィラーを加えていたため、その絶縁層は、弾性率が高いものであった。

【0018】

【特許文献1】

特開平11-8450号公報

【0019】

【発明が解決しようとする課題】

従来の金属ベース回路配線基板では、絶縁層にシリカ系フィラーとゴム系フィラーを充填することによって、高放熱性と低弾性を実現し、金属基板と、その上に実装された電子部品との線膨張の違いによって生じる応力が緩和され、電子部品の半田にクラックが発生することを抑制することが可能となった。

【0020】

図3中に、高温時における金属基板1、絶縁層2、そして、電子部品4の線膨張の様子が、矢印で示される。絶縁層2の線膨張について、ゴム系フィラーF1とシリカ系フィラーF2の充填率を調整することができ、線膨張による応力の緩和を実現するには、絶縁層2の線膨張が、電子部品4の線膨張よりは大きいが、金属基板1の線膨張より小さく抑えることとなる。

【0021】

しかしながら、金属ベース回路配線基板における絶縁層を低弾性化することによって、絶縁層の線膨張率が適当に調整されても、電子部品、絶縁層、金属基板の夫々の線膨張率には、差異があるため、高温環境下で、高温又は低温が繰り返される場合などでは、絶縁層と銅箔の配線パターン又は半田との半間の、さらには、絶縁層と金属基板との間の密着性が弱くなり、また、低弾性率の材料は、アルミニウムや、回路導体の銅との密着性が弱いため、夫々において各々の剥離が発生する可能性が高くなるという問題が発生する。

【0022】

そこで、本発明は、電子部品が実装された金属ベース回路配線基板を、線膨張率が調整された樹脂材料で樹脂封止することによって、105℃を超える高温環境下で使用される電子機器内に装着されるのに最適であり、金属基板本体の線膨張が電子部品などの実装に影響することを抑制した回路配線基板を提供することを目的とする。

【0023】

【課題を解決するための手段】

以上の課題を解決するため、本発明では、電子部品が、金属基板に積層された絶縁層上の配線パターンに実装された回路配線基板において、前記電子部品の実装部分を、前記絶縁層の線膨張率より小さい線膨張率を有する樹脂材料によって

樹脂封止するようにし、前記絶縁層は、高放熱性とする無機充填材と低弾性化する弾性充填材を含有する樹脂材料で形成され、前記樹脂封止する樹脂材料は、無機充填材が充填され、前記線膨張性と前記弾性が調整されていることとした。

【0024】

そして、前記無機充填材は、電気絶縁性及び高熱伝導性を有し、前記無機充填材は、酸化珪素、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、窒化珪素、窒化硼素から、一つ又は複数が選択されるものであり、前記金属基板は、アルミニウムベースであることとし、さらに、実装される前記電子部品は、前記配線パターンに半田付けされることとした。

【0025】

また、前記回路配線基板において、前記電子部品の実装部分が、前記樹脂材料によって前記絶縁層及び前記金属基板と一体的に樹脂封止されていることとした。

【0026】

【発明の実施の形態】

次に、本発明による回路配線基板の実施形態について、図1及び図2を参照して説明する。図1は、本実施形態による回路配線基板の断面図を示している。ここで、図1に示された回路配線基板は、図3に示された金属ベース回路配線基板の構成を基本にしている。そのため、図1に示された構成は、図3に示された構成と同じ部分には、同じ符号が付されている。

【0027】

図1に示された回路配線基板は、図3の回路配線基板と同様に、アルミニウム合金等の金属基板1をベースとしており、該金属基板1上に絶縁層2が形成されている。この絶縁層2上には、銅等による導電箔の配線パターン3₁乃至3₃が形成され、チップ等の電子部品4が、配線パターン3₁と3₂を跨ぐように電気接続されている。電子部品4と配線パターン3₁又は3₂との電気接続は、半田5₁及び5₂の半田付けで行われている。

【0028】

そして、金属基板1の上に形成される絶縁層2は、回路配線基板が高温環境下

に置かれたときに、金属基板1の線膨張の影響が電子部品4に伝わり難くなるよう、その応力を緩和する役割を持ち、図4に示されるように、弾性充填材としてゴム系フィラーF₁が、そして、高放熱性化の無機充填材としてシリカ系フィラーF₂が充填されている。

【0029】

これまで説明した回路配線基板の構成のままでは、図3に示した回路配線基板と同じであり、電子部品4、絶縁層2、金属基板1の夫々の線膨張率には、差異があるため、該回路配線基板が高温環境下に置かれると、絶縁層と銅箔の配線パターン又は半田との間で、さらには、絶縁層と金属基板との間で、各々の剥離が発生する可能性がある。

【0030】

そこで、本実施形態の回路配線基板では、上述の構成による電子部品4の実装部分に対して、無機充填材を充填した樹脂により樹脂封止することとした。樹脂に無機充填材を充填することにより、樹脂の線膨張率が適当に調整されて、低線膨張、かつ高弾性化を図っている。回路配線基板の樹脂封止の様子が、図1に示されており、絶縁層2上に形成された封止樹脂6が、電子部品4、配線パターン3₁乃至3₃、半田5₁及び5₂を含めて樹脂封止している。

【0031】

図2に、封止樹脂6の内部構成について、その拡大断面図により模式的に示した。封止樹脂6のベースは、例えば、エポキシ系の樹脂Rであり、この樹脂Rに、無機充填材として、例えば、シリカ系フィラーF₃が充填されている。このシリカ系フィラーF₃の充填率を大きさによって、封止樹脂6の線膨張率が調整される。通常、樹脂の線膨張率は、金属の線膨張率より大きく、無機充填材を充填することによってその線膨張率を小さくすることができる。

【0032】

封止樹脂6の線膨張率は、絶縁層2の線膨張率より小さく、電子部品4の線膨張率よりは大きくなるように調整される。電子部品4を実装した回路配線基板を、この線膨張率が調整された樹脂によって樹脂封止することにより、電子部品4、半田5₁及び5₂、配線パターン3₁乃至3₃、そして絶縁層2を夫々機械的

に固定化することができる。この固定化の様子は、図1において、矢印で示される。

【0033】

例えば、金属基板1に、厚さ2mmのアルミニウム板を用い、金属基板1の線膨張率は、1°Cにつき23ppmであり、絶縁層2に、シリカ系フィラーとゴム系フィラーと充填した厚さ90μmのエポキシ樹脂を用いて、その線膨張率を、16～20ppmに調整する。厚さ70μmの銅箔による配線パターンに半田付けされる電子部品4にICチップを用いた場合には、電子部品4の線膨張率は、セラミック基板と同様な線膨張率となり、4～7ppmである。

【0034】

そこで、封止樹脂6を形成するエポキシ樹脂にシリカ系フィラーを充填することによって、該樹脂の線膨張率を、絶縁層2の線膨張率より低く低線膨張化し、高弹性化しておく。この様に、封止樹脂6の線膨張率を、絶縁層2の線膨張率より低くされるので、当該樹脂封止された回路配線基板が高温環境化に置かれたとき、金属基板1が、大きく線膨張しても、絶縁層2が、電子部品4、配線パターン3₁乃至3₃に及ぼす応力が緩和され、さらに、封止樹脂6が、高温環境下でも膨張することなく、外力が加わったとき収縮が少くなり、電子部品4、半田5₁及び5₂、配線パターン3₁乃至3₃及び絶縁層2が一体的かつ機械的に固定化される。

【0035】

そのため、この様な構成を有する回路配線基板を、自動車のエンジルーム等のような高温環境下に搭載される電子制御装置に組み込んでも、絶縁層と銅箔の配線パターン又は半田との間で、さらには、絶縁層と金属基板との間で、各々における剥離の発生を抑制することができる。

【0036】

また、封止樹脂に充填される無機充填材として、シリカ系フィラーを用いた場合に従って、本実施形態の回路配線基板を説明したが、絶縁層に充填される無機充填材と同様に、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、窒化珪素、窒化ホウ素等を用いることができ、これらの単独系でも、混合系でも用いることができる。

電気絶縁性が良好で、しかも高熱伝導率のものであればよい。

【0037】

なお、本実施形態の回路配線基板の説明において、封止樹脂にエポキシ樹脂を例にしたが、本実施形態の実施に当たっては、このエポキシ樹脂に限られること無く、他の種々の封止用樹脂を用いてもよい。樹脂封止することによって、電子部品の実装を機械的に固定化するだけでなく、高熱伝導率材料を充填すれば、放熱性の向上に役立つものであり、充填材料によっては、耐湿性の向上、外力からの保護といった効果を持たせることもできる。

【0038】

図1には、本実施形態の回路配線基板の一部が代表的に表されており、実際には、金属基板上に種々の電子部品が実装されている。無機充填材が充填された樹脂によって樹脂封止する場合には、少なくともこれらの電子部品の実装部分が該樹脂で封止される必要があり、これらの電子部品と金属基板との全体を一体的に樹脂封止することもできる。

【0039】

上述した実施形態では、主として、自動車などに搭載される電子制御装置等の制御回路装置に適用した場合で説明したが、本発明は、係る用途に限定されるものではなく、他の回路接続装置、例えば、省力機器の制御回路接続装置、通信機器の制御回路接続装置等についても、同様に適用することができ、同様の効果が得られるものである。

【0040】

【発明の効果】

以上のように、本発明の回路配線基板では、無機充填材の充填によって線膨張率が調整された樹脂によって樹脂封止するようにしたので、封止樹脂によって電子部品、半田、配線パターンが金属基板に固定化され、特に、回路配線基板が高温環境下に置かれても、絶縁層と半田又は配線パターンとの間、さらには、絶縁層と金属基板との間において、剥離の発生を抑制することができる。

【0041】

このため、従来のように、高温環境下での使用に耐える高耐熱性のセラミック

基板を使用する必要がなくなり、回路配線基板のベースに金属、特に、安価で製造が容易なアルミニウム合金を用いることが実現できた。

【0042】

また、無機充填材が充填された樹脂によって回路配線基板を樹脂封止したので、無機充填材の高熱伝導性により、封止樹脂が放熱性を有し、実装された電子部品の放熱効果を向上することになる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本実施形態による樹脂封止された回路配線基板の断面図である。

【図2】

本実施形態の樹脂封止回路配線基板における封止樹脂の拡大断面図である。

【図3】

従来技術による電子部品搭載の回路配線基板の断面図である。

【図4】

図3に示された回路配線基板における絶縁層の拡大断面図である。

【符号の説明】

1 … 基板

2 … 絶縁層

3₁ ~ 3₃ … 配線パターン

4 … 電子部品

5₁、5₂ … 半田

6 … 封止樹脂

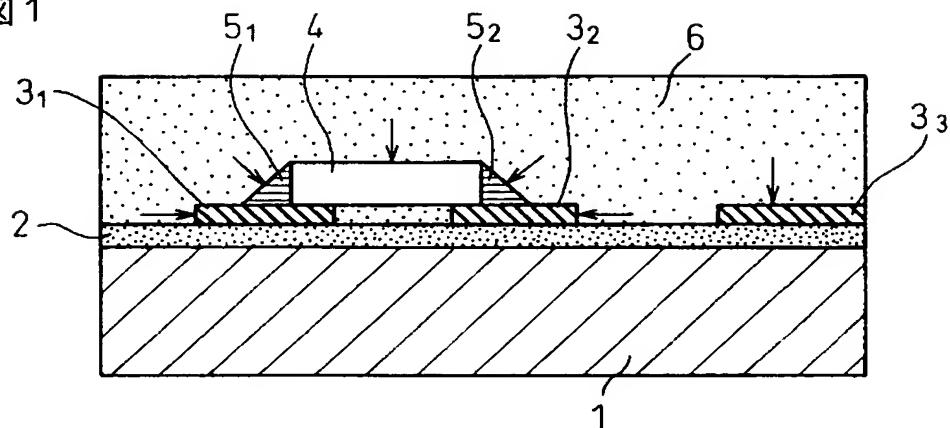
F₁ ~ F₃ … フィラー

R … 樹脂材料

【書類名】 図面

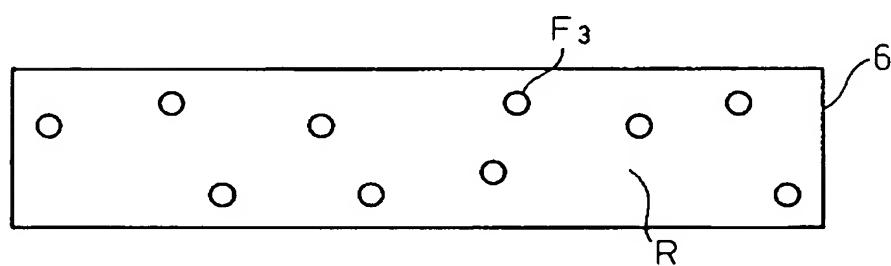
【図1】

図1



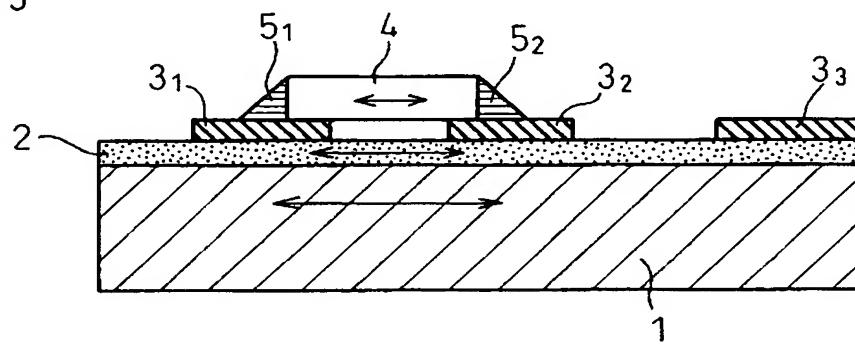
【図2】

図2



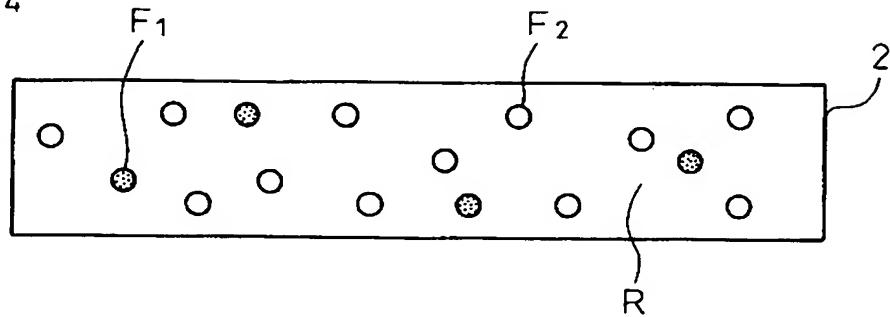
【図3】

図3



【図4】

図4



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明は、高温環境下で使用される電子機器内に装着されるのに最適であり、金属基板本体の線膨張が電子部品などの実装に影響することを抑制した回路配線基板に関する。

【解決手段】 回路配線基板において、電子部品4が、金属基板1に積層された絶縁層2上の配線パターン3₁乃至3₃に実装されている。電子部品は、半田5₁、5₂で配線パターンに半田付けされている。絶縁層は、シリカ系フィラーとゴム系フィラーとの充填により、低線膨張化、高弾性化されている。回路配線基板は、電子部品の実装部分を覆うように、シリカ系フィラーが充填され、絶縁層の線膨張率より小さく調整された線膨張率を有する樹脂材料によって樹脂封止される。金属基板の線膨張による応力を緩和し、高温環境下でも、絶縁層と半田又は配線パターン、絶縁層と金属基板における剥離の発生を抑制できる。

【選択図】 図1

特願2002-342556

出願人履歴情報

識別番号 [000237592]

1. 変更年月日 1990年 8月29日
[変更理由] 新規登録
住 所 兵庫県神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号
氏 名 富士通テン株式会社